

Сведения о ведущей организации

по кандидатской диссертации Текутьевой Вероники Олеговны на тему
«Ориентация и субструктура плёнок карбида кремния на кремнии,
синтезированных методом фотонной обработки»
по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ИПМаш РАН
Ведомственная принадлежность	Минобрнауки РФ
Тип организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки (ФГБУН)
Почтовый индекс, адрес организации	199178, Большой проспект Васильевского острова, дом 61, литера А.
Веб-сайт	ipme.ru
Телефон	+7 (812) 321-47-78
Адрес электронной почты	ipmash@ipme.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15):

1. Osipov A.V. Epitaxial silicon carbide on silicon. method of coordinated substitution of atoms (a review) / S.A. Kukushkin, A.V. Osipov // Russian Journal of General Chemistry. – 2022. – Т. 92. – № 4. – С. 584-610.

2. Осипов А.В. Фазовые переходы в эпитаксиальных слоях карбида кремния, выращенных на кремниевой подложке методом согласованного замещения атомов / Н.Т. Баграев, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, В.Л. Уголков // Физика и техника полупроводников. – 2022. – Т. 56. – № 7. – С. 715-718.

3. Осипов А.В. Рост пленок SiC, AlN и GaN на кремниевых изделиях произвольной геометрии для микроэлектромеханических применений / Т.Т. Кондратенко, А.С. Гращенко, А.В. Осипов, А.В. Редьков, Е.В. Убийвовк, Ш.Ш. Шарофидинов, С.А. Кукушкин // Письма в Журнал технической физики. – 2023. – Т. 49. – № 11. – С. 3-6.

4. Осипов А.В. Эволюция структуры при превращении Si в SiC методом самосогласованного замещения атомов / С.А. Кукушкин, М.Г. Воробьев, А.В. Осипов, А.С. Гращенко, Е.В. Убийвовк // Физика твердого тела. – 2024. – Т. 66. – № 7. – С. 1133-1143.

5. Осипов А.В. Взаимодействие кремниевых вакансий в карбиде кремния / С.А. Кукушкин, А.В. Осипов // Письма в Журнал технической физики. – 2024.

– Т. 50. – № 21. – С. 19-23.

6. Осипов А.В. Магнитная восприимчивость гибридных структур SiC/Si, синтезированных методом самосогласованного замещения атомов / С.А. Кукушкин, Н.И. Руль, Е.В. Убыйвовк, А.В. Осипов, В.В. Романов, Н.Т. Баграев // Физика твердого тела. – 2025. – Т. 67. – № 4. – С. 624-634.

7. Осипов А.В. Природа стабильных и метастабильных состояний электронной структуры вакансионных нитей на поверхности карбида кремния / С.А. Кукушкин, А.В. Осипов // Письма в Журнал технической физики. – 2026. – Т. 52. – № 5. – С. 45-49.

8. Osipov A.V. Three stages of Si transformation into SiC by the method of coordinated substitution of atoms / S.A. Kukushkin, E.V. Ubyivovk, M.G. Vorobev, A.S. Grashchenko, A.V. Osipov // Thin Solid Films. – 2026. – Т. 839. – С. 140908.

9. Осипов А.В. Кристаллическая структура и электронные свойства полукогерентной границы раздела 3C-SiC(111)/Si(111) / А.В. Осипов, А.С. Гращенко, Е.В. Осипова, Е.В. Убыйвовк, С.А. Кукушкин // Физика твердого тела. – 2026. – Т. 68. – № 4. – С. 397-402.

Руководитель организации

Александр

Полянский Владимир Анатольевич

Дата

